

委 員 各 位

日本学術振興会ワイドギャップ半導体
光・電子デバイス第 162 委員会
委員長 吉川 明彦

日本学術振興会ワイドギャップ半導体光・電子デバイス第 162 委員会
第 81 回委員会・第 85 研究会 開催案内

日時：平成 25 年 7 月 17 日（水）

委員会：12:00 - 13:00

研究会：13:00 - 17:20

場所：主婦会館プラザエフ(B2F クラルテ)

(JR 四ツ谷駅 麴町口 徒歩1分)

〒102-0085 東京都千代田区六番町 15 番地 TEL: 03-3265-8111

http://plaza-f.or.jp/?page_id=2565

委員会

議 題：

- (1) 前回第 80 回委員会議事要録承認について
- (2) 委員の異動について
- (3) 次回第 86 回研究会以降の研究会について
- (4) 平成 24 年度決算について
- (5) 平成 25 年度予算について
- (6) ワイドギャップ半導体スクール (10/24-10/26 開催予定) について
- (7) その他

報告事項：

- (1) APWS2013 (5/12-15@台湾) 開催報告
- (2) 「知識や技術の伝承取りまとめ」出版記念シンポジウム(7/16@東京)開催報告
- (3) 国際会議 IC-II-VI 2013 (2013/9/9-9/13 開催予定) について
- (4) 国際シンポジウム ISPlasma 2014 (2014/3/2-3/6 開催予定)協賛依頼
- (5) その他

研究会

主 題：「酸化物エレクトロニクスの進展」

「委員長挨拶・企画の趣旨説明」(13:00 ~ 13:05)

1. 「IGZO を用いた液晶ディスプレイの低消費電力化技術」(13:05-13:45)
松尾 拓哉 (シャープ株式会社 ディスプレイデバイス開発本部)
2. 「アモルファス酸化物 TFT を用いた RFID の試作」(13:45-14:25)
内山 博幸、尾崎 太亮、河村 哲史、若菜 裕紀、山添 孝徳
(日立中央研究所)

3. 「高移動度酸化物半導体を用いた薄膜トランジスタの開発」(14:25-15:05)

江端 一晃、笈井 重和、霍間 勇輝、飯塚 隆、矢野 公規
(出光興産株式会社 先進技術研究所)

休 憩(15:05-15:20)

4. 「酸化物半導体結晶のエピタキシャル成長とその界面物性」(15:20-16:00)

大友 明 (東京工業大学)

5. 「多結晶酸化亜鉛透明導電膜におけるキャリア輸送:

理論と実験的制御、粒界散乱の神話を壊す」(16:00-16:40)

山本 哲也¹、宋 華平¹、野本 淳一¹、牧野 久雄¹、岸本 誠一^{1,2}
(高知工科大学¹、高知高専²)

6. 「高効率 ZnO/Cu₂O ヘテロ接合太陽電池」(16:40-17:20)

宮田 俊弘、南内 嗣 (金沢工業大学)

<追記>

1. 委員会では、出席のご回答をいただいた委員に昼食をご用意いたします。
2. 準備の都合上、委員会・研究会の出欠回答を7月8日(月)までに日本学術振興会研究事業課 檜崎 様 (jigyouka09@jsps.go.jp) 宛に、必ずご連絡くださいますようお願いいたします。